

トランジスタ

2SC2076

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

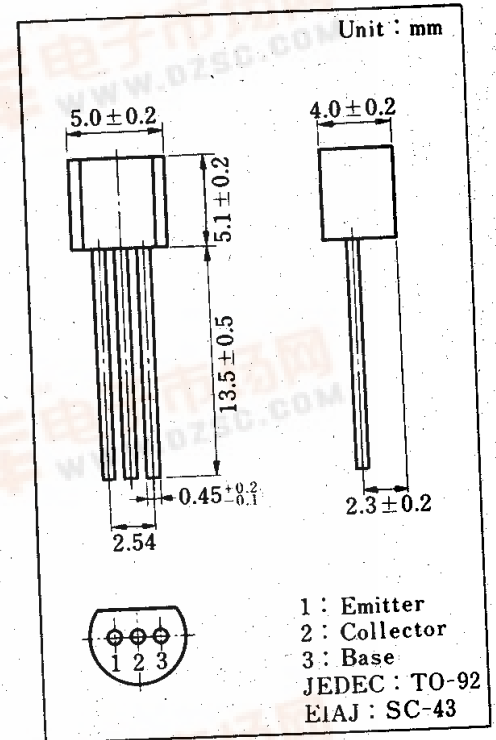
高周波増幅用 / RF Amplifier

■ 特徴 / Features

- AM/FM ラジオの RF 増幅, 発振, 混合, IF に最適です。
Suitable for RF amp., OSC, mix. and IF amp. in FM/AM radios.
- サージ破壊強度が大きい。 / Large with standing capability against surge voltage.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	35	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	30	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	4	V
コレクタ電流	I_C	20	mA
コレクタ損失	P_C	400	mW
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{ V}, I_E=0$			1	μA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=10\ \mu\text{A}, I_E=0$	35			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=2\ \text{mA}, I_B=0$	30			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=10\ \mu\text{A}, I_C=0$	4			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE}=10\ \text{V}, I_C=1\ \text{mA}$	80		360	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\ \text{mA}, I_B=1\ \text{mA}$			0.4	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB}=10\ \text{V}, I_E=-1\ \text{mA}$	80		200	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\ \text{V}, I_E=0, f=1\ \text{MHz}$			3.5	pF
雑音指数	NF	$V_{CB}=10\ \text{V}, I_E=-1\ \text{mA}, f=100\ \text{MHz}$			5	dB

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

Class	B	C	D
h_{FE}	80 ~ 160	120 ~ 240	180 ~ 360

